

	<h2 style="color: red;">SI7382DP-T1-GE3</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SI7382DP-T1-GE3</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 30V 14A PPAK SO-8</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI7382DP-T1-GE3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 3020 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	SI7382DP-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 14A PPAK SO-8
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	3020 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4.7 mOhm @ 24A, 10V
Verlustleistung (max)	1.8W (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	40nC @ 4.5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 14A (Ta) 1.8W (Ta) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	14A (Ta)

SI7382DP-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI7382DP-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI7382DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI7382DP-T1-GE3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SI7382DP</b> SI SI7382DP SI</p>	 <p><b>SI7384DP-T1-E3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 11A PPAK SO-8</p>	 <p><b>SI7382DP-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 14A PPAK SO-8</p>	 <p><b>SI7384DP</b> SI SI7384DP SI</p>
 <p><b>SI7384DP-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 11A PPAK SO-8</p>	 <p><b>SI7382DP-T1-E3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 14A PPAK SO-8</p>	 <p><b>SI7380DP-T1-GE3</b> VISHAY VISHAY PAKSO-8</p>	 <p><b>SI7384DP-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 11A PPAK SO-8</p>

### SI7382DP-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

<b>Schlüsselwort</b>	Electro-Films (EFI) / Vishay	SI7382DP-T1-GE3	Datenblatt	SI7382DP-T1-GE3-Datenblätter	SI7382DP-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI7382DP-T1-GE3
SI7382DP-T1-GE3 Electronic	SI7382DP-T1-GE3-Komponenten	SI7382DP-T1-GE3-Verteiler	SI7382DP-T1-GE3-Bild	SI7382DP-T1-GE3 Aktie	SI7382DP-T1-GE3 Inventar	SI7382DP-T1-GE3 Online bestellen
SI7382DP-T1-GE3 Preis	SI7382DP-T1-GE3 Hersteller	SI7382DP-T1-GE3 garantiert	SI7382DP-T1-GE3 RFQ			

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited